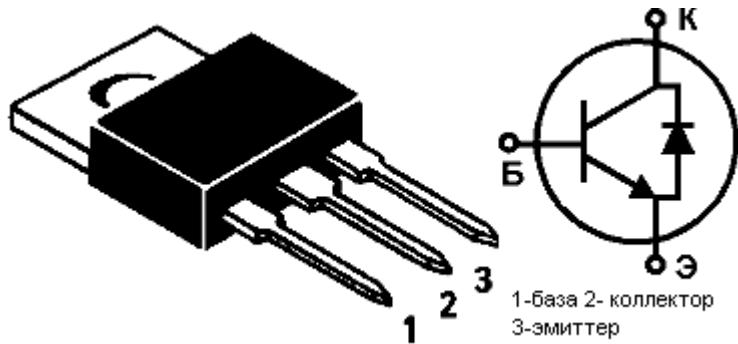


# ПИР-1. NPN кремниевый мощный высоковольтный транзистор

## Краткий информационный лист



Предназначен для использования в быстродействующих схемах переключения с индуктивной нагрузкой, в импульсных схемах, а также в усилителях мощности с высокой линейностью. Имеет встроенный диод в цепи коллектор-эмиттер.

### Максимально-допустимые параметры

Наименование параметра	Обозначение	Величина	Ед.изм.
Напряжение коллектор-база	$U_{CBO}$	850	В
Напряжение коллектор-эмиттер ( $I_B=0$ )	$U_{CEO}$	450	В
Напряжение эмиттер-база	$U_{EB}$	7	В
Постоянный ток коллектора	$I_C$	20	А
Импульсный ток коллектора	$I_{CM}$	30	А
Постоянный ток базы	$I_B$	5	А
Импульсный ток базы	$I_{BM}$	15	А
Постоянная рассеиваемая мощность	$P_D$	125*	Вт
Диапазон рабочих температур перехода	$\Delta T_j$	-55 до +150	С
Максимальная температура перехода	$T_{j\ max}$	+150	С

\* - при  $T_{корн} = +25$  С

### Электрические характеристики

Наименование параметра, режим измерения	Обозначение	Величина		Ед. изм.
		мин.	макс.	
Граничное напряжение коллектор-эмиттер ( $I_C=200\text{mA}$ , $I_B=0$ )	$U_{CEO(\text{sus})}$	450		В
Обратный ток коллектор-база ( $U_{CB}=850\text{V}$ )	$I_{CBO}$		0.5	mA
Обратный ток эмиттер-база ( $U_{EB}=6\text{V}$ )	$I_{EBO}$		0.1	mA
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{CE}=5\text{V}$ , $I_C=10\text{A}$ )	$h_{FE}$	8		
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_C=10\text{A}$ , $I_B=2\text{A}$ )	$U_{CE(\text{sat})}$		1.3	В
Напряжение насыщения база-эмиттер ( $I_C=10\text{A}$ , $I_B=2\text{A}$ )	$U_{BE(\text{sat})}$		1.5	В
Прямое напряжение на диоде коллектор-эмиттер ( $I_{PP}=30\text{A}$ )	$U_{PP}$		2	В
Емкость перехода коллектор-база ( $U_C=10\text{V}$ , $I_3=0$ , $f=1\text{МГц}$ )	$C_{OB}$		400	пФ

Близкими зарубежными аналогами транзистора "Пир-1" являются приборы BUV-48, MJ13333, MJW16010, MJW16110 фирмы MOTOROLA. Ориентировочная оптовая цена на II кв. 1999 г. - 25 руб. 80 коп. Возможна поставка транзисторов в корпусе KT9 (TO-3)